

IP2369 应用说明文档

版本/修订历史

版本	日期	修订内容	拟制/修订人
V1.00	2024.4.19	初版释放	IT555





一、IP2369 烧录说明

1. 固件升级工具说明

英集芯 BUCKBOOST 固件量产升级工具如图 1:



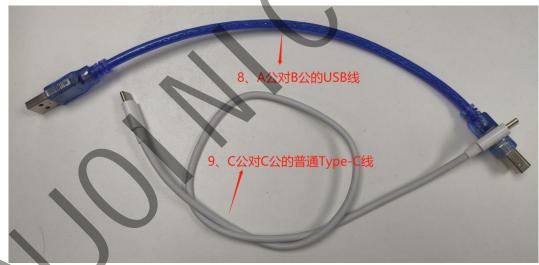


图 1 英集芯固件升级工具实物图

功能简述

- (1) 固件升级模式选择:往左拨,选择 DPDM 升级方式(仅可以使用 DPDM 模式);升级模式要跟固件版本和芯片型号对应,否则固件是无法升级成功的;
- (2) 方形 USB 母座:通过 A 公对 B 公的 USB 线(常用于打印机的线),连接到电脑或 5V 适配器;连接电脑后可以拷贝要升级的固件到升级工具中(升级工具相当于 U 盘,断电后固件不会丢失);给待升级样机升级时,该 USB 需要 5V 供电,可以使用电脑或 5V 适配器供电;
- (3) Type-C 母座: 通过 C 公对 C 公的 USB Type-C 的线,连接到需要升级固件的待升级样机;
- (4) Connect 连接按键:按下就尝试连接,连接成功则点亮"Connect OK"指示灯,呈绿色;



- (5) Update 升级按键:按下就开始升级固件,固件升级过程中,"Connect OK"指示灯持续闪烁;
- (6) 状态指示灯:

Ready: 检查升级工具电源是否 OK, 检查待升级样机是否已连接, 如供电正常, 且待升级样机已经正确连接, 则点亮"Ready"指示灯, 呈绿色;

Connect OK: 按下 Connect 连接按键就尝试连接,连接成功即识别到带升级样机可被升级,则点亮"Connect OK"指示灯,呈绿色:

Pass/Fail: 按下 Update 升级按键就开始升级固件,固件升级过程中,"Connect OK"指示灯持续闪烁; 升级结束,"Connect OK"停止闪烁; 如固件升级成功,则点亮"Pass"指示灯,呈绿色; 如升级失败,则点亮"Fail"指示灯,呈红色;

- (7) 复位按键:按下则将升级工具强制复位,模式选择开关更改后,需要按下复位键才能生效;
- (8) A 公对 B 公的 USB 线(常用于打印机的线): 连接电脑或 5V 适配器;
- (9) C 公对 C 公的 USB Type-C 线: 连接升级工具和待升级的样机;

2. 升级固件更新

- (1) 将固件升级工具的方形 USB 母座,通过 USB 线(常用于打印机的线)连接到电脑(windows 操作系统):
- (2) 第一次连接电脑,会安装驱动程序,升级工具是免驱动安装的;等驱动安装完成后,就会弹出 U 盘;
- (3) 把要更新的升级固件拷贝进 U 盘;要注意,拷贝进去的固件会自动隐藏,是看不到升级工具内原来的固件的,所以在不确定升级工具内固件版本时,建议重新拷贝固件;
- (4) 固件拷贝完成后,退出 U 盘;固件更新完成,固件断电后是不会丢失的;

3. 固件升级步骤

- (1) 将固件升级工具的方形 USB 母座用 5V 供电,可以连接到电脑或 5V 的适配器;
- (2) 将固件升级工具的 Type-C 母座,用 Type-C 线连接到待升级样机(待升级样机可以不供电,升级工具会通过 Type-C 口给待升级样机提供 5V 供电):

根据固件和芯片所支持的升级模式,将拨码开关拨到对应的升级模式上(模式选择更改后,需要按下升级工具的复位键才能生效);

DPDM 升级模式,必需要 DPC/DMC 信号连接到芯片管脚上;

- (3) 等待"Ready"指示灯亮起,"Ready"指示灯亮起说明升级环境检查 OK; 否则,"Ready"灯不亮,说明连接有问题,不能升级固件,请检查连接性(升级工具是否有 5V 输入,待升级样机的 Type-c 口功能是否正常);
- (4) Connect 连接按键,尝试连接:

者"Connect OK"指示灯亮,说明固件升级工具与样机连接成功,表示样机支持升级;

若"Connect OK"指示灯不亮,或者"Fail"指示灯亮起,说明固件升级工具与样机连接失败,表示样机不支持升级;请检查确认:待升级样机上的芯片型号跟升级工具内的固件型号是否匹配?待升级样机是否可以正常工作?"模式选择"开关是否设置正确?固件是否有升级转换?

(5) 在连接成功的基础上("Connect OK"指示灯灯亮),按下 Update 升级按键,开始升级固件,固件升级过程中,"Connect OK"指示灯持续闪烁;"Connect OK"停止闪烁,说明升级完成;

通过"Pass"/"Fail"指示灯来判断升级结果:

若"Pass"指示灯亮,说明固件升级成功;



若"Fail"指示灯亮,说明固件升级失败;请检查确认:待升级样机上的芯片型号跟升级工具内的固件型号是否匹配?待升级样机是否可以正常工作?

(6) 若固件升级成功,断开升级工具和待升级样机的 Type-C 线连接,重新进行步骤 2 升级下一台样机;升级工具可以不用断电(方形的 USB 口不用拔出);

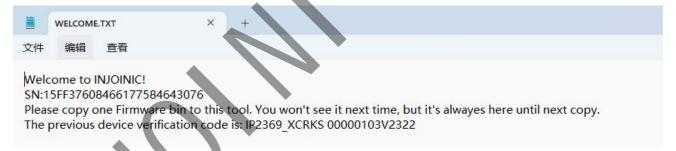
4. 烧录厂用自动升级工具使用说明

烧录厂用的自动升级工具,硬件跟上面说到的升级工具是一样的,只是工具软件不一样,请按照 "IP2369 升级工具"来申请购买,IP2369 升级工具包含 IP2368/IP5389 升级功能;

已购买了"IP2368 升级工具/IP5389 升级工具"的可以寄回我司进行升级兼容 IP2369 升级功能。

5. 升级工具读取芯片内固件型号

- (1) 按照上述第三点"**固件升级步骤**"来正确连接,但不要进行 Update 升级
- (2) 连接成功后单击一次复位键
- (3) 复位后打开电脑上升级工具所在的储存盘-->打开"WELCOME"TXT 文件,文件中能读到当前芯片内的 固件版本: IP2369_XCRKS,WCIQO 就是某一型号的时间戳,每一份固件的时间戳都是不一样的,可通过此时间戳去确定 IC 固件对应的型号



6. 注意事项

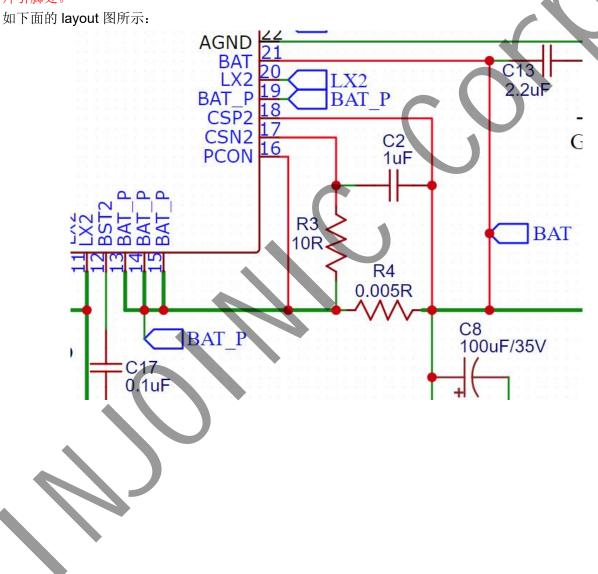
- (1) IP2369 仅有一种烧录升级固件的模式: DPDM 升级 (对应 C1 口的 DMC、DPC 两个 PIN) Sockect 子板和升级工具是通过 C 口连接的
- (2) 烧录升级模式若不正确是无法升级固件的,升级前需要确认:固件升级工具的升级模式(拨码开关选择)是否正确、固件的型号是否能烧录到 IC上,只要有其中 1 个不对,都是无法烧录升级固件的;



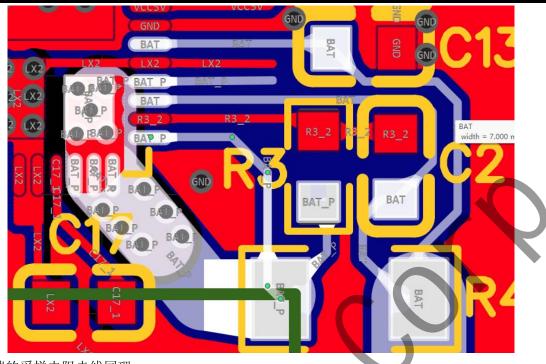
二、IP2369 layout布局走线注意事项

1. VIO 端和 BAT 端采样线需要单独从采样电阻两端引出,且越短越好

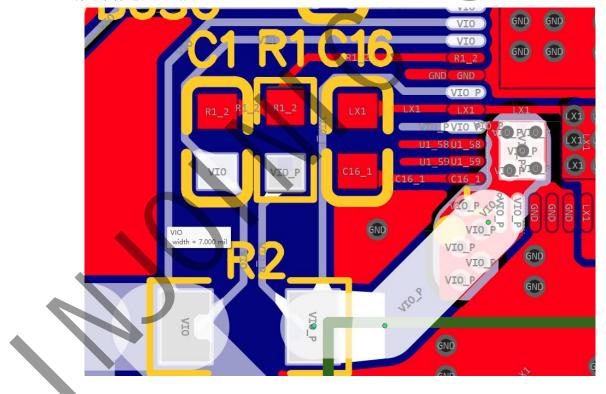
在原理图中,引脚 BAT、CSP2 属于同一网络,但是走线时**必须单独分别**从采样电阻右侧引出;CSN2和 PCON 也需要**单独分别**从采样电阻左侧引出,其中采样线上的 RC(R1,C1,R3,C2)需要放置在靠近芯片引脚处。







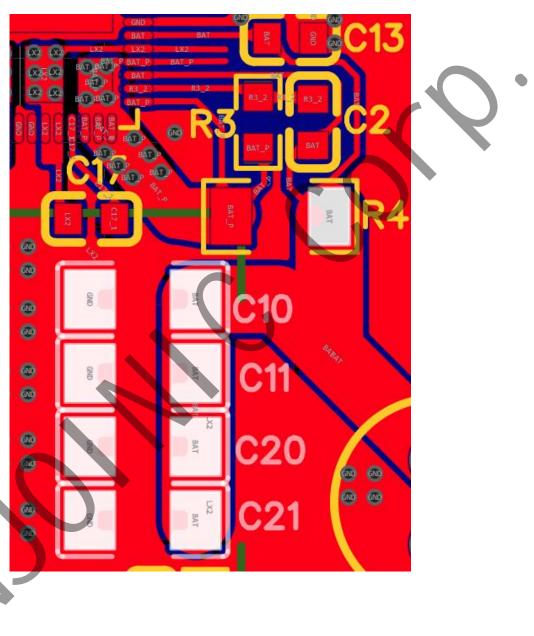






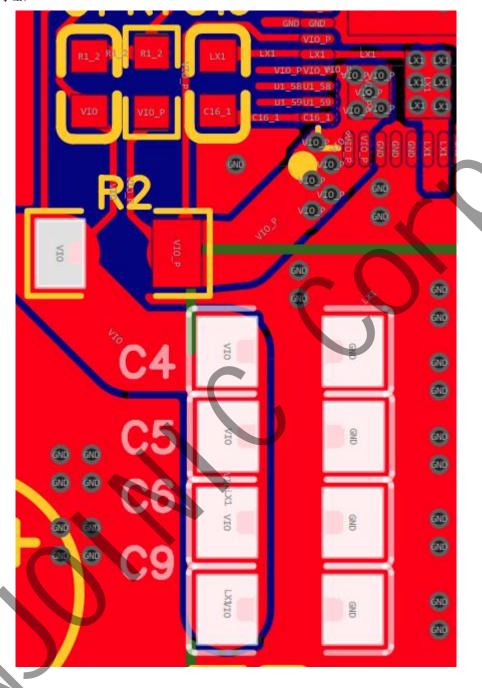
2. VIO 和 BAT 端电容需要靠近采样电阻

以BAT 端为例,该端的采样电阻旁边**必须至少**放置一个 22uF 电容。在这个前提下尽可能使电容的 GND 靠近 BAT 功率回路下管的 GND,另外**地孔越多越好**。否者可能会对电流 ADC 的采样的精确与稳定造成影响。





VIO 端布局同理,





三、IP2369常见问题汇总

器件选型相关问题:

1. CSP2/CSN2 及 CSP1/CSN1 脚的采样精度值是多少?采样电路上的电阻和电容作用是什么,如何取值?

电流采样的精度受内部修调基准、采样放大倍数匹配误差、以及采样电阻自身精度、PCB 走线和焊接效果的影响。在不考虑采样电阻误差的情况下,采样精度仅能保证<2%,要实现更高的精度,需要再贴片完成之后,在正常工作中测试实际的偏差,通过软件对偏差进行系数修调。

我们抽测了 3 块 IP2369 的 demo 板, 平均电流采样精度在 1.3%左右。

采样电路上的电阻和电容的作用是作为低通滤波器, VBUS 端阻值选择 51R, 容值选择 470nF,则该滤波器的截止频率为 32K; BAT 端阻值选择 10R, 容值选择 1uF,则该滤波器的截止频率为 16KHz,与开关频率(250kHz)相差 8 倍和 16 倍,主要是对采样电流的开关纹波进行滤波。

2. 两颗自举电容容值如何选择?

在 IP2369 中,自举电容的供电来源是 VCC5V,为了上管导通时 BST 电容电压的稳定,一般需要符合 C_{Vcc5V} > C_{BST} >> C_{iss} ,大部分情况下, C_{BST} =100 C_{iss} ,在 H 桥 MOS 的 C_{iss} 不超过 1nF(1000pF)的情况下,常规取值为 100nF(0.1uF)。

3. C口的滤波电容一般多少合适?

一般来说,输出口的电容容值建议最大不要超过 22uF,不然可能会影响 EMI 认证的通过,而且过大的输出口电容可能会带来负载检测误触发等问题。所以我们推荐使用 10uF,也可以额外并联一个 0.1uF 电容来减少 EMI 干扰。

4. 在实际应用中,CC/D+/D-上一般都会增加一些电阻电容,它们的取值有什么公式吗?

大部分情况下,在 CC/D+/D-上增加电阻和电容是为了通过一些认证,具体的取值不太容易靠理论计算出来,影响这些参数的因素有很多,比如 PCB 的布局和走线,很多时候都需要在实际的板子上进行一步步调整,最后才能得到合适的参数。



5. VIO 和 BAT 的电容如何选择? 为何推荐 2 个 22uF 并联 1 个 100uF

根据开关电源的电容计算公式, VIO 和 BAT 的电容容值最小为 100uF, 又考虑到在实际的使用过程中, 电容容值可能会随着使用时间的增加或者温度上升而减少, 我们进行了大量的充放电实验, 最后才得出使用 2 个 22uF 和 1 个 100uF 的电容推荐参数。另外, 输出口的电容只是进行简单的滤波, 使用 0.1uF 即可。

6. 去掉 BAT 端的固态电容会有什么危害?

电池接入 BAT 端时,会产生浪涌高压。用 demo 板(有固态电容)使用 24V 电池组测试,BAT 端接上电池瞬间波形时平滑的,没有尖峰值,测试芯片引脚 BAT 最大电压 25.5V,芯片无异常。去掉 BAT 端固态电容,芯片 BAT 引脚处烧毁,峰值电压可以达到 90V 以上如下图所示。增加 30V 的 TVS,接上电池瞬间尖峰电压为 67V,虽然测试中未损坏芯片但是仍存在损坏芯片的可能。所以固态电容能有效吸收接入电池时的浪涌电压,不可以省掉固态电容或者用陶瓷电容代替。

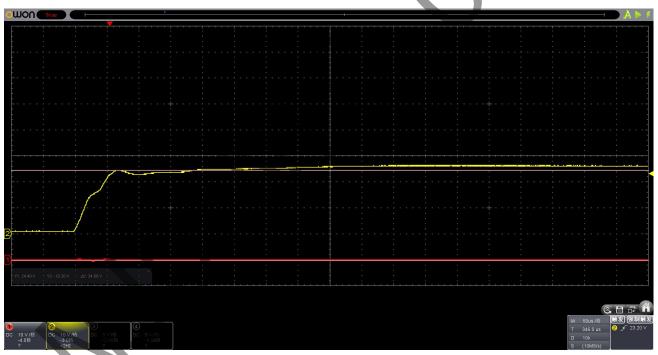


图 1 demo 板测试



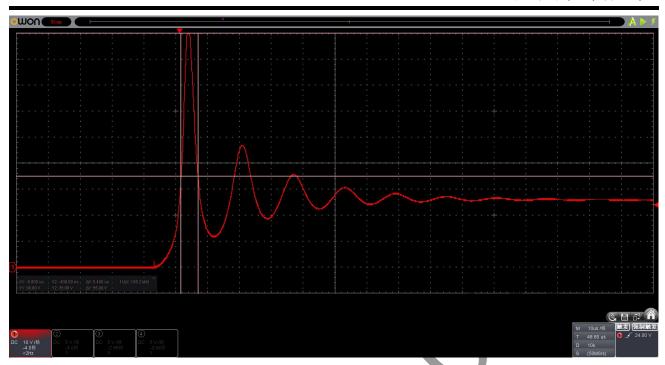


图 2 BAT 端 100uF 固态电容去除之后

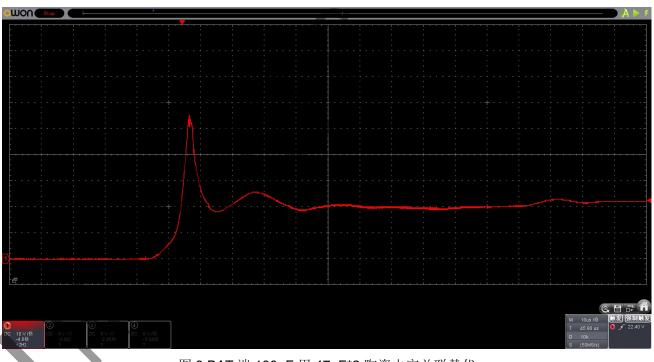


图 3 BAT 端 100uF 用 47uF*2 陶瓷电容并联替代



系统功能相关问题

1. VBUS 的路径 NMOS 应当如何选型

答: VBUS 的 NMOS 只是作为路径开关,对开关速度的要求并不高。关于导通阻抗 $R_{DS\ (ON)}$,我们推荐路径 NMOS 的 $R_{DS\ (ON)}$ <10mR.,这个值越小,整体的效率越高。 V_{DS} 耐压则需要根据实际情况选择,例如,选用的方案最高支持 20V 充放电,则路径 NMOS 的 V_{DS} 耐压需要大于 20V (考虑到裕量,建议大于 30V);如果选用的方案最高支持 15V 充放电,则路径 NMOS 的 V_{DS} 耐压需要大于 15V(考虑到裕量,建议大于 20V)。

2. 电感如何选型,为何推荐使用 4.7uH 的电感?

答: 我们预设 IP2369 功率回路输出电流为 I_{OUT} ,开关频率为 f_s ,输入电压 V_{IN} ,输出电压为 V_{OUT} . 根据项目具体要求,按 4 串电池 45W 充电。 电感感量计算公式:

$$L = \frac{V_{IN} * D * (1-D)}{f_s * \Delta I_L}$$

由公式可知, 当D=0.5时, D*(1-D)最大, L就最大。

充电 BUCK 时, $D=rac{V_{OUT}}{V_{IN}}$, V_{IN} =20V, V_{OUT} =12~16.8V, f_s =250kHz。

在上述工作条件下,当 V_{OUT} =12V, V_{IN} =20V 时,D*(1-D) 达到最大。

$$I_{out} = \frac{V_{IN*}I_{IN}}{V_{OUT}} = \frac{45W}{12V} = 3.75A$$

算上功率损耗,取 I_{out} =4A 计算

电感纹波电流 ΔI_L 一般取 $0.2I_{out}$ ~ $0.4I_{out}$,这里取 0.3 倍,则 ΔI_L =1.2A。

带入电感计算公式可得: L=4.7uH

电感电流计算公式如下:

$$I_{L(max)} = I_{out} + 0.5*\Delta I_L$$

 $I_{L(min)} = I_{out} - 0.5*\Delta I_L$

计算得到 $I_{L(max)}$ =4.35A, $I_{L(min)}$ =3.15A.

电感的感值取 4.7uH,额定电流看具体使用场景而定,一般来说最少需要大于 7A,直流阻抗则越低越好。

3. 为什么通过 I2C 读取到的 IP2369 电流数据波动很大?

答:检查 PCB 中 VIO 端和 BAT 端的 5mR 采样电阻的采样线是否有重合,每个 5mR 两端分别引出两根采



样线到IC的采样引脚,不能有重合。采样线不能从电感下面经过,不然电感会干扰采样信号。

4. 为什么设置的 IP2369 充电电流是 3A, 但是实际充电电流是 2.8A-3A?

答: 首先是不同 IC 体质不同,其中的校准参数设置有差异,实际充电电流会有±5%的差异;然后由于不同客户,layout 差异导致采样会有浮动,出于对适配器的输出能力考虑,3A 的电流我们实际设置低于 3A,保证适配器不会被过大的电流拉保护。

5. IP2369 的 A/C 口输入输出方案中, 充电功率和放电功率可以分开设置吗?

答:标准的 IP2369 的 A/C 口输入输出方案中,充电功率和放电功率只能同时设置,不可以分别设置;但是可以定制。

6. IP2369 电池放到低电保护之后,等电池电压恢复之后可以重新放电吗?

答: IP2369 标准方案在电池放电到低电保护之后, 等电池电压恢复后就可以重新放电,可以定制不同的电池低电电压。

7. IP2369 的 INT 脚到底应该怎么处理?

答: INT 默认接 510K 到地,因为 IP2369 的 INT 如果上拉到高电平,就不会进入待机状态,首次上电无法通过给 INT 高电平来唤醒 IP2369,只能通过 EN 唤醒,随后进入 100uA 待机后,可通过拉高 INT 来唤醒 IP2369.

8. 为什么会出现无法申请快充的情况?

答:检查一下 PCB 板,IC 与座子的 DPDM 和 CC 线是否正常连接,因为快充申请是需要用到 DPDM 和 CC 线进行通信的,而有部分样式的 C 口座子不易焊接,容易导致上述线路无法正常连接。建议选用便于焊接的座子。

9. 当 IP2369 进行 36W/45W 功率充放电时,电感和功率 IC 的温度会很高?

答:因为电感和 IC 内置的 MOS 中有阻抗,从几毫欧到几十毫欧,在功率达到 36-45W 的情况下,电感的电流会有 3-5A 的电流,这样电感和 IC 内置 MOS 管中损耗的几瓦能量都用在发热上且导致电流峰值达不到,功率 MOS 的开关频率也相应增加,开关损耗增加导致发热严重。选用电感时,电感的直流阻抗越低越好。



10. 为什么真实的功率和设置的功率偏差较大?

答:检查采样电阻的阻值和精度,以及采样电阻上的 RC 电路阻抗是否与规格书上的相同,否则会影响到采样精度,继而影响到真实的功率。

11. IP2369 出现拔掉输入线之后, I2C 充电标志还在?

答:检查板子 layout 是否良好,输入端和输出端 5mR 采样线重点检查,电流采样误差太大会导致我们无法准确采样到板子充电状况,导致输入端拔出之后,还是采样到有输入电流,导致 I2C 充电标志还在。

12. 待机状态, 空载状态, 放电状态, 充电状态怎么相互转换?



13. 多口输出和单口输出怎么互相转换?

答: 当处于多口输出模式时,任一输出口的输出电流小于约 80mA(MOS Rds_ON@15mohm)时,持续 16s 后会自动关闭该口。



从多个用电设备减少到只有一个用电设备时,持续约 16s 后会先关闭所有输出口,开启高压快充功能,再开启最后一个用电设备存在的输出口,以此方式来重新激活设备请求快充。

当只有一个输出口开启的情况下,总的输出功率小于 350mW 持续约 32s 时,会关闭输出口和放电功能,进入待机状态。

14.IP2369 边冲边放怎么实现?

答: 当同时连接充电电源和用电设备时,自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭内部快充输入请求。为保证用电设备的正常充电,IP2369 会将充电欠压环路提高到 4.9V 以上,以保证优先给用电设备供电。在 VIO 电压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;为了安全考虑,如果 VIO 电压大于5.6V,不会开启放电路径。

在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,IP2369 会关闭充电功能,重新启动放电功能给用电设备供电。为了安全考虑,同时也为了能够重新激活用电设备请求快充,转换过程中会有一段时间输出电压掉到 0V。

在边充边放过程中,如果拔掉用电设备、用电设备充满或者停止抽电持续约 16s 时,IP2369 会自动关闭对应的放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路、自动重新申请快充,加速给电池充电。

15. 测试充放电 36W/45W 时,板子温度很高,且会发生断充?

答: 36W/45W 功率、充放电,板子热很正常,断充是因为 IC 过温保护了; 可以通过降低功率或者增加电池节数来改善; 以及优化 PCB 发热元件的布局,加厚铜箔来加快散热。

16.在实际应用过程中,可以删掉一些输出口吗,如果可以的话,相应输出口的功能 pin 应当如何处理呢?

答:可以删除。

比如在某个应用中删除的输出口是 USB-A,那么与 USB-A 相关的 DMA1、DPA1、VOUT1、VOUT1G 也就没有作用了,此时可以将 VOUT1G、DMA1、DPA1 引脚悬空,但需要保留 VOUT 上的 10uF 电容。如果是删除 Type-C 口,那么相应的引脚悬空即可。



四、EMC调试建议

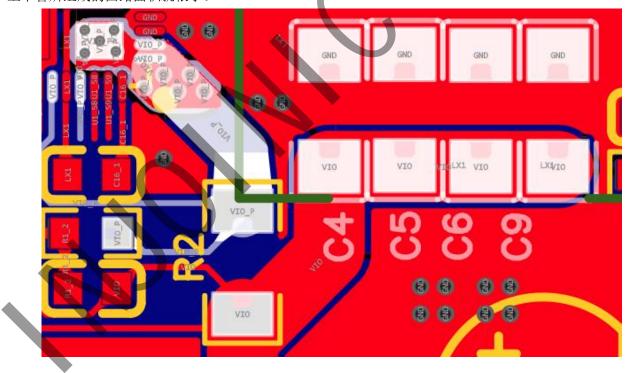
在 IP2369 的应用中,要想获得比较良好的 EMC 表现,需要从下面两个方向下手:

1. 修改 RC 电路参数

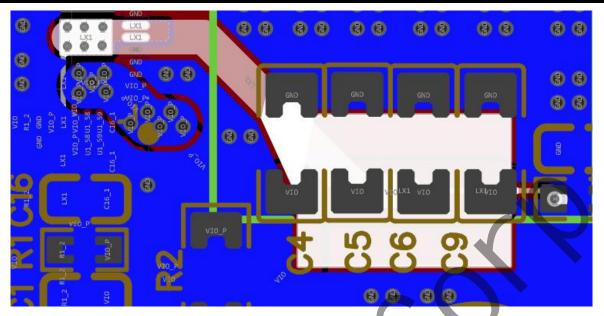
(1) H 桥开关节点 LX 到 GND 的 RC 参数。H 桥开关的过程中,电流变化迅速,这会引起电磁干扰。通过添加 RC 吸收电路,可以减少开关节点上的电流变化带来的噪声。我们推荐的 RC 值为 2R 2.2nF,当 H 桥的 EMC 表现不够好时,可以尝试将 RC 增加到 2R 3.3nF 或 2R 4.7nF,但是需要注意,更大的 RC 也会带来更多的效率损失

2. PCB Layout

(1) 半桥的上下管和对应的输入输出电容的摆放最为重要,需要摆放在输入输出路径上靠近上下管的地方,且尽可能保证电容与上下管形成的回路面积小。该面积越小,在开关电路工作时,不同的电流路径之间的面积差也就越小,产生的电磁辐射干扰也就更少。以下图为例,VIO 端电容的正负端、上下管所组成的回路面积就很小。







(2)输入输出电流回流路径顺畅也十分关键。以放电输出场景为例,正向的输出电流,从 VIO 上管流出,经过采样电阻、VIO 电容,最后达到各个输出口,该路径大部分情况下都会以铜箔的形式规划好路径,一般都比较顺畅,而输出口的 GND 到 VIO 下管 GND 的路径 基本都是通过最后的大面积铺铜来实现的,拥有顺畅的 PCBA 回流路径也有必要的,这可以减少辐射。虽然在实际的项目应用 PCB 绘制中,座子,H 桥的 GND 之间器件会多一些,但是也应该提前做好器件规划,让回流路径尽可能地顺畅。

